This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

011780733

WPI Acc No: 1998-197643/199818

XRAM Acc No: C98-063004 XRPX Acc No: N98-156697

Radiation sensitive resin compsn. - comprises substd.-naphthalene acid

generating agent which dissolves resin. Patent Assignee: NIPPON GOSEI GOMU KK (JAPS) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date 19980220 JP 96219125 A. 19960802 199818 B. JP 10048814 Α

Priority Applications (No Type Date): JP 96219125 A 19960802 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 15 G03F-007/004 JP 10048814 Α

Abstract (Basic): JP 10048814 Af

Radiation sensitive resin compsn. contains (A) resin to be alkali soluble by dissociating of acid dissociation function gp. by action of acid and (B) radiation sensitive acid generating agent of formula (1).

Formula (1-1)-p

R1 = H or hydroxyl gp.; R2-R4 = one of R2, R3 and R4 is gp. of formula (2) and others are mutually and independently, H, cyano gp., hydroxyl gp., nitro gp., straight chain or branched alkyl gp. or straight chain or branched alkoxyl gp.

Formula (2)-p

R5, R6 = mutually and independently, straight chain or branched

alkyl gp.
USE - The compsn. is used for resist suitable for hyperfine

ADVANTAGE - The compsn. has high transparency to ArF excimer laser (wavelength 193 nm) and improved sensitivity, resolution, developing property, pattern shape and the like. The compsn. is suitable for chemical amplification type resist using radiation of short wavelength of 220 nm or less in manufacture of IC elements. Dwg. 0/0

Japanese Patent Provisional Publication No. 10-48814/1998

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-48814

(43)公開日 平成10年(1998) 2月20日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
G03F	7/004	503		G03F 7/00	4 503	
	7/039	501		7/039	9 501	
H 0 1 L	21/027			H 0 1 L 21/30	502R	

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 15 頁)

(21)出願番号	特顯平8-219125	(71)出職人 000004178
		日本合成ゴム株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)8月2日	東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者 諏訪 充史
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(72)発明者 梶田 徹
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(72)発明者 岩永 伸一郎
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(74)代理人 弁理士 福沢 俊明
	4	

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

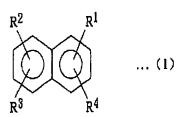
【課題】 波長が220nm以下の放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、現像性、パターン形状等に優れた感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)酸の作用により酸解離性官能基が解離してアルカリ可溶性となる樹脂、および(B)ナフチルジアルキルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート類(但し、アルキル基の炭素数は1~4)および/またはそれらの各置換誘導体(但し、置換基は、シアノ基、水酸基、ニトロ基、炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~4のアルコキシル基)を含有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)酸の作用により酸解離性官能基が解離してアルカリ可溶性となる樹脂、および(B)下記式(1)で表される感放射線性酸発生剤

【化1】



〔式中、 R^1 は水素原子または水酸基を示し、 R^2 、 R^3 および R^4 のうち、一つは基

【化2】

$$\frac{\text{CF}_{3}\text{SO}_{3}^{-}}{\text{R}^{6}} > \text{S}^{\frac{+}{-}}$$

(但し、R⁵ およびR⁶ は相互に独立に直鎖状あるいは 分岐状のアルキル基を示す。)を示し、その他のものは 相互に独立に水素原子、シアノ基、水酸基、ニトロ基、 直鎖状あるいは分岐状のアルキル基、または直鎖状ある いは分岐状のアルコキシル基を示す。]を含有すること を特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関わり、さらに詳しくは、波長が220nm以下の放射線を用いる超微細加工に有用なレジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近ではサブハーフミクロンオーダー (0. 4 μ m以下) の微細加工を可能にするリソグラフィー技術の開発が進 められており、近い将来には、サブクオーターミクロン (0. 20 μ m以下) レベルの微細加工技術が必要にな るとされている。従来のリソグラフィープロセスに使用 されている代表的なレジストでは、一般に放射線として i線等の近紫外線が用いられているが、近紫外線ではサ ブクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難で ある。そこで、サブクオーターミクロンレベルの微細加 工を実現するために、より波長の短い放射線の利用が検 討されている。このような短波長の放射線としては、例 えば、KrFエキシマレーザー (波長248nm) ある いはArFエキシマレーザー(波長193nm)に代表 される遠紫外線や、X線、電子線等を挙げることができ るが、これらのうち、特に遠紫外線が注目されている。 このような遠紫外線による照射に適した感放射線性樹脂 組成物として、酸解離性官能基を有する成分と放射線の

照射(以下、「露光」という。)により酸を発生する感 放射線性酸発生剤とからなる化学増幅型感放射線性組成 物が数多く提案されている。この化学増幅型感放射線性 組成物は、酸解離性官能基を有する成分が、露光によっ て生じた酸の作用により、その酸解離性官能基が解離さ れてアルカリ可溶性となることによって、レジストパタ ーンが形成されるものである。しかしながら、従来の化 学増幅型感放射線性組成物は、遠紫外線に対して感応す る感放射線性酸発生剤の機能が必ずしも十分でないた め、特に感度あるいは形状といったレジストの基本特性 を損なうことなく、その他のレジスト性能を十分制御す ることが困難であるという欠点を有していた。例えば、 ArFエキシマレーザー (波長193nm) に対する透 明性の高い感放射線性酸発生剤(例えばシクロヘキシル メチル (2ーオキソシクロヘキシル) スルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート等)を用いた場合、遠紫外 線の吸収が小さく、酸の発生効率が低くなるため、露光 により発生する酸の量が酸解離性官能基に対して相対的 に少なくなり、酸解離性官能基の解離が有効に行われな いという欠点がある。したがって、良好なレジストパタ ーンを形成させるためには、より多くの放射線で露光す る必要があり、感度が低下するという問題があった。一 方、ArFエキシマレーザー(波長193nm)に対す る透明性の低い感放射線性酸発生剤(例えばトリフェニ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等)を 用いると、酸の発生効率は高くなるが、遠紫外線の吸収 が大きくなるため、有効な露光量がレジスト上層部では 多く、下層部では少なくなり、現像後のレジストパター ンが、上部が細く下部にいくほど太い台形状になり、パ ターン形状が損なわれるという問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、波長が220nm以下の放射線に対する透明性が高く、しか も感度、解像度、現像性、パターン形状等に優れた感放 射線性樹脂組成物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、(A)酸の作用により酸解離性官能基が解離してアルカリ可溶性となる樹脂、および(B)下記式(1)で表される感放射線性酸発生剤

[0005]

【化1】

【0006】 〔式中、 R^1 は水素原子または水酸基を示し、 R^2 、 R^3 および R^4 のうち、一つは基

[0007]

【化2】

【0008】(但し、R⁵ およびR⁶ は相互に独立に直 鎖状あるいは分岐状のアルキル基を示す。)を示し、そ の他のものは相互に独立に水素原子、シアノ基、水酸 基、ニトロ基、直鎖状あるいは分岐状のアルキル基、ま たは直鎖状あるいは分岐状のアルコキシル基を示す。〕 を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物、に より達成される。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の (A) 成分である酸の作用により酸解離性官能基が解離 してアルカリ可溶性となる樹脂(以下、「樹脂(A)」 という。)としては、例えば、アルカリ現像液に可溶な 樹脂(以下、「アルカリ可溶性樹脂」という。)中のア ルカリ現像液に親和性を示す酸性官能基(例えば、フェ ノール性水酸基、カルボキシル基等) の水素原子の少な くとも一部を、酸の作用により容易に解離する1種以上 の酸解離性官能基で置換した構造を有する、それ自体と してはアルカリ不溶性あるいはアルカリ難溶性の樹脂を 挙げることができる。ここで言う「アルカリ不溶性ある いはアルカリ難溶性」とは、本発明の感放射線性樹脂組 成物を用いてレジストパターンを形成する際に採用され るアルカリ現像条件下で、樹脂(A)のみを用いて形成 された被膜を現像したとき、当該被膜の初期膜厚の50 %以上が現像後に残る性質を意味する。このような酸解 離性官能基としては、例えば、tーブチル基、tーブト キシカルボニル基、アセチル基、1-メトキシエチル 基、1-エトキシエチル基、1-n-プロポキシエチル 基、イソプロポキシエチル基、1-n-ブトキシエチル 基、1-イソブトキシエチル基、1-sec-ブトキシ エチル基、1-t-ブトキシエチル基、1-n-ペント キシエチル基、テトラヒドロピラニル基、メチルテトラ ヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、メチルテ トラヒドロフラニル基、カルボブトキシメチル基、2-(カルボブトキシ) エチル基、2-カルボ (ブトキシ) プロピル基、3-(カルボブトキシ)プロピル基、トリ アルキルシリル基等を挙げることができる。これらの酸 解離性官能基のうち、tーブチル基、tーブトキシカル ボニル基、1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル 基、1-n-ブトキシエチル基、テトラヒドロピラニル 基、メチルテトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラ ニル基、メチルテトラヒドロフラニル基が好ましい。樹 脂(A)中の酸解離性官能基の導入率(酸解離性官能基 と酸性官能基との合計数に対する酸解離性官能基の数の 割合) は、酸解離性官能基やアルカリ可溶性樹脂の種類 により一概には規定できないが、好ましくは5~100 モル%、さらに好ましくは20~100モル%である。 酸解離性官能基の導入率が5モル%未満では、レジスト としての解像度が低下する傾向がある。

【0010】樹脂(A)は、例えば、(イ)予め製造したアルカリ可溶性樹脂に1種以上の酸解離性官能基を導入する方法、(ロ)1種以上の酸解離性官能基を有する重合性単量体を(共)重合する方法、(ハ)1種以上の酸解離性官能基を有する重縮合性成分を(共)重縮合する方法等により製造することができる。以下、これらの方法について説明する。(イ)の方法において、アルカ

リ可溶性樹脂としては、ナフトール性水酸基あるいはカ ルボキシル基の如き酸性官能基を1種以上有する、アル カリ現像液に可溶な樹脂が好ましい。このような好まし いアルカリ可溶性樹脂としては、酸性官能基を有する少 なくとも1種の重合性単量体(以下、「単量体(a) 1)」という。)の重合性二重結合が開裂した繰返し単 位を有する付加重合系樹脂(以下、「アルカリ可溶性樹 脂(a)」という。)を挙げることができる。単量体 (a 1) の具体例としては、2-ヒドロキシ-1-ビニ ルナフタレン、3-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレ ン、4-ヒドロキシー1-ビニルナフタレン、5-ヒド ロキシー1ービニルナフタレン、6ーヒドロキシー1ー ビニルナフタレン、7-ヒドロキシ-1-ビニルナフタ レン、8-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレン、1-ヒ ドロキシー2-ビニルナフタレン、3-ヒドロキシー2 ービニルナフタレン、4ーヒドロキシー2ービニルナフ タレン、5-ヒドロキシー2-ビニルナフタレン、6-ヒドロキシー2ービニルナフタレン、7ーヒドロキシー 2-ビニルナフタレン、8-ヒドロキシ-2-ビニルナ フタレン、2-クロロー3-ヒドロキシー1ービニルナ フタレン、3-クロロー4-ヒドロキシー1-ビニルナ フタレン、4ークロロー3ーヒドロキシー1ービニルナ フタレン、4-プロモー3-ヒドロキシー1-ビニルナ フタレン、4-メチル-3-ヒドロキシ-1-ビニルナ フタレン、4-エチルー3-ヒドロキシー1-ビニルナ フタレン、3-n-プロピル-4-ヒドロキシ-1-ビ ニルナフタレン、3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-1 ービニルナフタレン、、2ーメチルー4ーヒドロキシー 1ービニルナフタレン、2,6ージメチルー4ーヒドロ キシー1-ビニルナフタレン等のヒドロキシービニルナ フタレン類:

【0011】2-ヒドロキシ-1-イソプロペニルナフ タレン、3-ヒドロキシ-1-イソプロペニルナフタレ ン、4-ヒドロキシー1-イソプロペニルナフタレン、 5-ヒドロキシー1-イソプロペニルナフタレン、6-ヒドロキシー1-イソプロペニルナフタレン、7-ヒド ロキシー1ーイソプロペニルナフタレン、8ーヒドロキ シー1-イソプロペニルナフタレン等のヒドロキシーイ ソプロペニルナフタレン類;2-カルボキシー1ービニ ルナフタレン、3-カルボキシ-1-ビニルナフタレ ン、4-カルボキシ-1-ビニルナフタレン、5-カル ボキシ-1-ビニルナフタレン、6-カルボキシ-1-ビニルナフタレン、7-カルボキシ-1-ビニルナフタ レン、8-カルボキシ-1-ビニルナフタレン等のカル ボキシービニルナフタレン類;2ーカルボキシー1ーイ ソプロペニルナフタレン、3-カルボキシ-1-イソプ ロペニルナフタレン、4-カルボキシ-1-イソプロペ ニルナフタレン、5-カルボキシ-1-イソプロペニル ナフタレン、6-カルボキシ-1-イソプロペニルナフ タレン、7-カルボキシー1-イソプロペニルナフタレ ン、8-カルボキシ-1-イソプロペニルナフタレン等 のカルボキシーイソプロペニルナフタレン類:3-カル ボキシー2-メトキシー1-ビニルナフタレン、4-カ ルボキシー2ーメトキシー1ービニルナフタレン、5ー カルボキシー2-メトキシー1-ビニルナフタレン、6 -カルボキシ-2-メトキシ-1-ビニルナフタレン、 7-カルボキシー2-メトキシー1-ビニルナフタレ ン、8-カルボキシー2-メトキシー1-ビニルナフタ レン等のカルボキシーメトキシービニルナフタレン類; 3-カルボキシ-2-メトキシ-1-イソプロペニルナ フタレン、4-カルボキシ-2-メトキシ-1-イソプ ロペニルナフタレン、5-カルボキシ-2-メトキシー 1-イソプロペニルナフタレン、6-カルボキシー2-メトキシー1ーイソプロペニルナフタレン、7ーカルボ キシー2-メトキシー1-イソプロペニルナフタレン、 8-カルボキシ-2-メトキシ-1-イソプロペニルナ フタレン等のカルボキシーメトキシーイソプロペニルナ フタレン類; (メタ) アクリル酸、クロトン酸、マレイ ン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン 酸等の脂肪族不飽和カルボン酸類等を挙げることができ る。これらの単量体 (a 1) は、単独でまたは2種以上 を混合して使用することができる。アルカリ可溶性樹脂 (a) としては、ヒドロキシー1ービニルナフタレン 類、ヒドロキシ-1-イソプロペニルナフタレン類、カ ルボキシ-1-ビニルナフタレン類、カルボキシ-1-イソプロペニルナフタレン類、カルボキシーメトキシー 1-ビニルナフタレン類、カルボキシーメトキシー1-イソプロペニルナフタレン類、(メタ)アクリル酸、ク ロトン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラ コン酸およびメサコン酸の群から選ばれる少なくとも1 種の単量体(a1)の重合性二重結合が開裂した繰返し 単位を有する付加重合系樹脂が好ましい。

【0012】アルカリ可溶性樹脂(a)は、単量体(a 1) の重合性二重結合が開裂した繰返し単位のみから構 成されていてもよいが、生成した樹脂がアルカリ可溶性 である限り、酸性官能基をもたない重合性単量体(以 下、「単量体 (a 2)」という。) の重合性二重結合が 開裂した繰返し単位をさらに含有することができる。こ のような単量体 (a 2) としては、例えば、1-ビニル ナフタレン、4ーメチルー1ービニルナフタレン、5ー メチルー1-ビニルナフタレン、1-イソプロペニルナ フタレン、4-クロロ-1-ビニルナフタレン、5-ク ロロー1ービニルナフタレン、4ーメトキシー1ービニ ルナフタレン、5-メトキシ-1-ビニルナフタレン等 のナフタレン系ビニル化合物; (メタ) アクリル酸メチ ル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸 n ープロピル、(メタ) アクリル酸イソプロピル、(メ タ) アクリル酸 n - ブチル、(メタ) アクリル酸イソブ チル、(メタ)アクリル酸secーブチル、(メタ)ア クリル酸 t ープチル、(メタ) アクリル酸 2 - エチルヘ

キシル、(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ) アク リル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキ シブチル、(メタ) アクリル酸モノグリセロール、(メ タ) アクリル酸トリシクロデカニル、(メタ) アクリル 酸ジシクロペンテニル、(メタ) アクリル酸 2-(ジシ クロペンテニルオキシ) エチル、(メタ) アクリル酸ノ ルボニル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メ タ) アクリル酸アダマンチル、(メタ) アクリル酸アダ マンチルオキシメチル等の(メタ)アクリル酸エステル 類:メチルビニルエーテル、tーブチルビニルエーテ ル、イソブチルビニルエーテル等のビニルエーテル類; 酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニ スエステル類; (メタ) アクリロニトリル、αークロロ アクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニトリ ル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニ トリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合物; (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メタ) ア クリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマ ルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコ ンアミド等の不飽和アミド化合物; N-ビニルーε-カ プロラクタム、Nービニルピロリドン等の他の含窒素ビ ニル化合物等を挙げることができる。これらの単量体 (a2)は、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。本発明においては、レジスト被膜のアル カリ現像液に対する溶解性を調整するために、アルカリ 可溶性樹脂 (a) として、単量体 (a 1) と単量体 (a 2) との共重合体を使用することが好ましい。このよう な共重合体中の単量体 (a 1) に由来する繰返し単位の 含有率は、単量体(a1)あるいは単量体(a2)の種 類により一概に規定できないが、通常、2~95モル %、好ましくは5~80モル%である。単量体(a1) の、場合により単量体 (a 2) の存在下における (共) 重合は、各単量体あるいは反応媒質の種類に応じて、ラ ジカル重合開始剤、アニオン重合触媒、配位アニオン重 合触媒、カチオン重合触媒等の重合開始剤あるいは重合 触媒を適宜に選択し、塊状重合、溶液重合、沈澱重合、 乳化重合、懸濁重合、塊状-懸濁重合等の適宜の重合形 態で実施することができる。なお、アルカリ可溶性樹脂 (a) は、後述する(ロ)の方法について例示する1種 以上の酸解離性官能基を有する重合性単量体の(共)重 合体を得たのち、該酸解離性官能基を加水分解すること によって製造することもできる。また、(イ)の方法に おけるアルカリ可溶性樹脂(a)としては、所望によ り、例えば、ナフトール性水酸基、カルボキシル基等の 酸性官能基を1種以上有する重縮合性成分の(共)重縮 合によって得られる縮合系樹脂を使用することもでき る。(イ)の方法において、アルカリ可溶性樹脂(a) は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。

【0013】また、(ロ)の方法において、1種以上の 酸解離性官能基を有する重合性単量体(以下、「単量体 (a3)」という。)としては、前記(イ)の方法にお ける単量体(a1)のナフトール性水酸基あるいはカル ボキシル基中の水素原子を、前記酸解離性官能基で置換 した単量体が好ましい。単量体 (a 3) の具体例として は、4-t-ブトキシー1-ビニルナフタレン、5-t ープトキシー1ービニルナフタレン、4-t-ブトキシ -1-イソプロペニルナフタレン、5-t-ブトキシー 1-イソプロペニルナフタレン、4-t-ブトキシカル ボニルオキシー1ービニルナフタレン、5-t-ブトキ シカルボニルオキシー1ービニルナフタレン、4ーtー ブトキシカルボニルオキシー1-イソプロペニルナフタ レン、5-t-ブトキシカルボニルオキシ-1-イソプ ロペニルナフタレン、4-(1-メトキシエトキシ)-1-ビニルナフタレン、5-(1-エトキシエトキシ) -1-ビニルナフタレン、4-(1-メトキシエトキ シ) -1-イソプロペニルナフタレン、5-(1-エト キシエトキシ) -1-イソプロペニルナフタレン、4-トリメチルシリルオキシー1ービニルナフタレン、5-トリメチルシリルオキシー1ービニルナフタレン、4-トリメチルシリルオキシー1-イソプロペニルナフタレ ン、5-トリメチルシリルオキシ-1-イソプロペニル ナフタレン等のビニルナフタレン系化合物; (メタ) ア クリル酸 t - ブチル、(メタ) アクリル酸 t - ブトキシ カルボニル、(メタ)アクリル酸1-メトキシエチル、 (メタ) アクリル酸1-エトキシエチル、(メタ) アク リル酸テトラヒドロピラニル、 (メタ) アクリル酸テト ラヒドロフラニル等の(メタ)アクリル酸エステル類等 を挙げることができる。これらの単量体(a3)は、単 独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 本発明においては、レジスト被膜のアルカリ現像液に対 する溶解性を調整するために、単量体 (a 3) と、酸解 離性官能基をもたない1種以上の重合性単量体(以下、 「単量体 (a 4)」という。)とともに共重合させるこ とが好ましい。このような単量体 (a 4) としては、例 えば、前記単量体 (a 1) や、前記単量体 (a 2) のう ち酸解離性官能基をもたない単量体を挙げることができ る。この場合の全単量体中の単量体 (a3) の含有率 は、単量体(a3)あるいは単量体(a4)の種類によ り一概に規定できないが、通常、2~95モル%、好ま しくは5~80モル%である。単量体(a3)の、場合 により単量体 (a 4) の存在下における (共) 重合は、 各単量体あるいは反応媒質の種類に応じて、ラジカル重 合開始剤、アニオン重合触媒、配位アニオン重合触媒、 カチオン重合触媒等の重合開始剤あるいは重合触媒を適 宜に選択し、塊状重合、溶液重合、沈澱重合、乳化重 合、懸濁重合、塊状-懸濁重合等の適宜の重合形態で実

【0014】また、(ハ)の方法において、1種以上の

施することができる。

酸解離性官能基を有する重縮合性成分(以下、「重縮合 性成分(a1)」という。)としては、例えば、フェノ ール、o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾー ル、2,3-キシレノール、2,4-キシレノール、 2, 5-キシレノール、3, 4-キシレノール、3, 5 -キシレノール、2,3,5-トリメチルフェノール、 3, 4, 5-トリメチルフェノール、レゾルシノール、 カテコール、ピロガロール、1-ナフトール、2-ナフ トール等のフェノール性化合物のフェノール性水酸基中 の水素原子を、前記酸解離性官能基で置換した化合物を 挙げることができる。これらの重縮合性成分 (a 1) は、例えば、ホルムアルデヒド、トリオキサン、パラホ ルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、アセトアルデヒ ド、プロピルアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド等 のアルデヒド類と重縮合させることにより、樹脂(A) を生成する。また場合により、重縮合性成分(a1) を、酸解離性官能基をもたない重縮合性成分とともに使 用することもできる。

【0015】ここで、本発明における特に好ましい樹脂 (A) の具体例を、樹脂(A) 中の繰返し単位を構成す る単量体あるいはその組み合わせからなる (共) 重合体 として示すと、下記のものが挙げられる。 4-t-ブト キシー1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシー1-ビ ニルナフタレン共重合体、4-t-ブトキシカルボニル オキシー1ービニルナフタレン/4ーヒドロキシー1ー ビニルナフタレン共重合体、4-(1-エトキシエトキ シ) -1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシ-1-ビ ニルナフタレン共重合体、4-(1-n-ブトキシエト キシ) -1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレン共重合体、4-テトラヒドロピラニル オキシー1ービニルナフタレン/4ーヒドロキシー1ー ビニルナフタレン共重合体、4-メチルテトラヒドロピ ラニルオキシー1ービニルナフタレン/4ーヒドロキシ -1-ビニルナフタレン共重合体、4-テトラヒドロフ ラニルオキシー1-ビニルナフタレン/4-ヒドロキシ -1-ビニルナフタレン共重合体、4-メチルテトラヒ ドロフラニルオキシー1ービニルナフタレン/4ーヒド ロキシー1ービニルナフタレン共重合体、(メタ)アク リル酸 t ープチル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカ ニル/(メタ)アクリル酸共重合体、(メタ)アクリル 酸 t - ブトキシカルボニル/ (メタ) アクリル酸トリシ クロデカニル/ (メタ) アクリル酸共重合体、 (メタ) アクリル酸1-エトキシエチル/ (メタ) アクリル酸ト リシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸共重合体、 (メ タ) アクリル酸1-プトキシエチル/ (メタ) アクリル 酸トリシクロデカニル/(メタ)アクリル酸共重合体、 (メタ) アクリル酸テトラヒドロピラニル/ (メタ) ア クリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸共重 合体、(メタ) アクリル酸メチルテトラヒドロピラニル

/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) ア

クリル酸共重合体、 (メタ) アクリル酸テトラヒドロフ ラニル/(メタ)アクリル酸トリシクロデカニル/(メ タ) アクリル酸共重合体、(メタ) アクリル酸メチルテ トラヒドロフラニル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデ カニル/ (メタ) アクリル酸共重合体、 (メタ) アクリ ル酸 t -ブチル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカニ ル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピル共重合 体、(メタ) アクリル酸 t - ブトキシカルボニル/ (メ タ) アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル 酸2-ヒドロキシプロピル共重合体、(メタ)アクリル 酸1-エトキシエチル/ (メタ) アクリル酸トリシクロ デカニル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピル 共重合体、(メタ) アクリル酸1-プトキシエチル/ (メタ) アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アク リル酸2-ヒドロキシプロピル共重合体、(メタ)アク リル酸テトラヒドロピラニル/(メタ)アクリル酸トリ シクロデカニル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプ ロピル共重合体、(メタ) アクリル酸メチルテトラヒド ロピラニル/(メタ)アクリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピル共重合体、 (メタ) アクリル酸テトラヒドロフラニル/ (メタ) ア クリル酸トリシクロデカニル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピル共重合体、(メタ) アクリル酸メチ ルテトラヒドロフラニル/ (メタ) アクリル酸トリシク ロデカニル/ (メタ) アクリル酸2-ヒドロキシプロピ ル共重合体。

【0016】樹脂(A)のゲルパーミエーションクロマ トグラフィー(GPC)で求めたポリスチレン換算重量 平均分子量(以下、「Mw」という。)は、感放射線性 樹脂組成物の所望の特性により変わるが、好ましくは 2,000~100,000、さらに好ましくは5,0 00~60,000である。樹脂(A)のMwが2,0 00未満では、樹脂組成物の製膜性が低下する傾向があ り、一方100,000を超えると、現像性、解像度等 が低下する傾向がある。また、樹脂(A)のゲルパーミ エーションクロマトグラフィー (GPC) で求めたMw とポリスチレン換算数平均分子量(以下、「Mn」とい う。)との比(Mw/Mn))で定義される分散度は、 好ましくは1~5、さらに好ましくは1~3である。樹 脂(A)の分散度を前記範囲とすることにより、特に解 像度に優れた感放射線性樹脂組成物をもたらすことがで きる。本発明において、樹脂(A)は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。

【0017】次に、本発明の(B)成分である感放射線性酸発生剤は、前記式(1)で表される化合物(以下、「酸発生剤(B)」という。)からなる。酸発生剤

(B) は、露光により酸を発生する作用を有し、この酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性官能基が解離し、その結果、レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に可溶性となり、ポジ型のレジストパターンを

形成することができる。前記式(1)において、R5 お よびR6 の直鎖状のアルキル基としては、メチル基、エ チル基、n-プロピル基、n-ブチル基等の炭素数1~ 4の基が好ましく、また分岐状のアルキル基としては、 イソプロピル基、sーブチル基、tーブチル基等の炭素 数 $1\sim4$ の基が好ましい。さらに、 R^2 、 R^3 およびR4 の直鎖状あるいは分岐状のアルキル基としても、R5 およびR6 について挙げた炭素数1~4の基が好まし い。また、R2、R3 およびR4 の直鎖状のアルコキシ ル基としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキ シ基、n-ブトキシ基等の炭素数1~4の基が好まし く、また分岐状のアルコキシル基としては、イソプロポ キシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1 ~4の基が好ましい。このような酸発生剤(B)は、J. Am. Chem. Soc. Vol. 106, No. 15, 4121(1984)に記載さ れている合成法により容易に得ることができる。酸発生 剤(B)の具体例としては、1-ナフチルジメチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチ ルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1-ナフチルジイソプロピルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチルジ メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 4-ニトロ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチル ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-ニトロ-1-ナフ チルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、4-メチル-1-ナフチルジエチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-シアノ-1-ナ フチルジイソプロピルスルホニウムトリフルオロメタン スルホネート、4-ニトロ-1-ナフチルジイソプロピ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジイソプロピルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシー1-ナ フチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、5-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキ シー1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、5ーヒドロキシー1ーナフチルジエ チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5 ーヒドロキシ-1ーナフチルジイソプロピルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、5-シアノ-4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、5-ニトロー4-ヒドロキ シー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、5-シアノ-4-ヒドロキシ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、5-ニトロー4-ヒドロキシー1-ナフチル ジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー

ト、5-シアノ-4-ヒドロキシ-1-ナフチルジイソ プロピルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、5-ニトロー4-ヒドロキシー1-ナフチルジイソ プロピルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、5ーヒドロキシー4ーシアノー1ーナフチルジメチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4ーニトロー1ーナフチルジメチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキ シー4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4-ニトロー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4-シアノー 1-ナフチルジイソプロピルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、5-ヒドロキシー4-ニトロー1 ーナフチルジイソプロピルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、7-ヒドロキシー4-シアノー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、7ーヒドロキシー4ーニトロー1ーナフチル ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、7ーヒドロキシー4ーシアノー1ーナフチルジエチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4ーニトロー1ーナフチルジエチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、 7ーヒドロキ シー4-シアノー1-ナフチルジイソプロピルスルホニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、7ーヒドロキシ -4-ニトロ-1-ナフチルジイソプロピルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、5-メチル-4-ヒドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、5-エチル-4-ヒドロキ シ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、5-イソプロピルー4-ヒドロキシ -1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、5-t-ブチル-4-ヒドロキシ-1 ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、5ーメトキシー4-ヒドロキシー1ーナフ チルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、5-エトキシ-4-ヒドロキシ-1-ナフチルジ メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 5-メチルー4-ヒドロキシー1-ナフチルジエチルス ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-エチ ルー4-ヒドロキシー1-ナフチルジエチルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、5-イソプロピル -4-ヒドロキシ-1-ナフチルジエチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、5-t-プチル-4 -ヒドロキシ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、5-メトキシー4-ヒド ロキシ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、5-エトキシー4-ヒドロキシ -1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、

【0018】5ーヒドロキシー4ーメチルー1ーナフチ ルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、5-ヒドロキシー4-エチルー1-ナフチルジメチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4ーイソプロピルー1ーナフチルジメチル スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒ ドロキシー4-t-ブチル-1-ナフチルジメチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロ キシー4ーメトキシー1ーナフチルジメチルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー 4-エトキシ-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4-メ チルー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、5-ヒドロキシ-4-エチル-1 ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、5ーヒドロキシー4ーイソプロピルー1ー ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、5-ヒドロキシ-4-t-ブチル-1-ナフ チルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、5-ヒドロキシー4-メトキシー1-ナフチルジ エチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 5-ヒドロキシー4-エトキシー1-ナフチルジエチル スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒ ドロキシー4ーメチルー1ーナフチルジイソプロピルス ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒド ロキシー4-エチルー1-ナフチルジイソプロピルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロ キシー4-イソプロピルー1-ナフチルジイソプロピル スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒ ドロキシー4-t-ブチル-1-ナフチルジイソプロピ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4ーメトキシー1ーナフチルジイソプロピ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、5-ヒドロキシー4-エトキシー1-ナフチルジイソプロピ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4ーメチルー1ーナフチルジメチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、 7ーヒドロキ シー4-エチルー1-ナフチルジメチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-イソプロピルー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-t -ブチル-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-メトキ シー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、7ーヒドロキシー4ーエトキシー1 ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、7ーヒドロキシー4ーメチルー1ーナフチ ルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、7ーヒドロキシー4ーエチルー1ーナフチルジエチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、7-

ヒドロキシー4ーイソプロピルー1ーナフチルジエチル スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、7-ヒ ドロキシー4ーtーブチルー1ーナフチルジエチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 7ーヒドロ キシー4-メトキシー1-ナフチルジエチルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー 4-エトキシ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-メ チルー1-ナフチルジイソプロピルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-エチ ルー1-ナフチルジイソプロピルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-イソプ ロピルー1ーナフチルジイソプロピルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシ-4-t ーブチルー1ーナフチルジイソプロピルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-メトキシー1ーナフチルジイソプロピルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、7-ヒドロキシー4-エトキシー1ーナフチルジイソプロピルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート等を挙げることができ る。また、酸発生剤(B)の市販品には、4-ヒドロキ シー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート(商品名NDS-105、みどり化学 (株) 製) がある。

【0019】酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができ、また必要に応じて、同様に露光により酸を発生する作用を有する他の酸発生剤(以下、「酸発生剤(b)」という。)を併用することもできる。このような酸発生剤(b)としては、例えば、①オニウム塩、②ハロゲン含有化合物、③ジアゾケトン化合物、④スルホン化合物、⑤スルホン酸化合物等を挙げることができる。これらの酸発生剤(b)の具体例としては、下記に示すものを挙げることができる。

①オニウム塩

オニウム塩としては、例えば、ヨードニウム塩、スルホ ニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニ ウム塩等を挙げることができる。好ましいオニウム塩の 具体例としては、ジフェニルヨードニウムトリフレー ト、ジフェニルヨードニウムピレンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムドデシルベンゼンスルホネート、ビ ス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムドデシルベンゼンスルホネート、ビス (4-t-プチルフェニル) ヨードニウムナフタレンス ルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニ ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフ ェニルスルホニウムナフタレンスルホネート、 (ヒドロ キシフェニル) ベンゼンメチルスルホニウムトルエンス ルホネート、1 ー (ナフチルアセトメチル) チオラニウムトリフルオロメタンスルホネート、シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等を挙げることができる。

②ハロゲン含有化合物

ハロゲン含有化合物としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有ヘテロ環状化合物等を挙げることができる。好ましいハロゲン含有化合物の具体例としては、1,1ービス(4ークロロフェニル)-2,2,2ートリクロロエタン、フェニルービス(トリクロロメチル)-sートリアジン、メトキシフェニルービス(トリクロロメチル)-sートリアジン、ナフチルービス(トリクロロメチル)-sートリアジン等を挙げることができる。

③ジアゾケトン化合物

ジアゾケトン化合物としては、例えば、1,3-ジケトー2ージアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げることができる。好ましいジアゾケトンの具体例としては、1,2-ナフトキノンジアジドー4ースルホニルクロリド、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,1,1-トリス(4ーヒドロキシフェニル)エタンの1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル等を挙げることができる。

④スルホン化合物

スルホン化合物としては、例えば、βーケトスルホン、βースルホニルスルホン等を挙げることができる。好ましいスルホン化合物の具体例としては、4ートリスフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン等を挙げることができ

⑤スルホン酸化合物

スルホン酸化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。好ましいスルホン酸化合物の具体例としては、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリストリフルオロメタンスルホネート、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ペプトー5ーエンー2,3ージカルボキシイミド、Nーヒドロキシスクシンイミドリフルオロメタンスルホネート、1,8ーナフタレジカルボキシイミドトリフルオロメタンスルホネート等を挙げることができる。これらの酸発生剤(b)のうち、

特に、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスル ホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、シクロヘキ シルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ジメチル (2-オキソシクロへ キシル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、 N-ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスル ホネート、1,8ーナフタレンジカルボキシイミドトリ フルオロメタンスルホネートが好ましい。前記酸発生剤 (b) は、単独でまたは2種以上を混合して使用するこ とができる。本発明における酸発生剤(B)と酸発生剤 (b) との合計使用量は、レジストとしての感度および 現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に 対して、通常、0.1~10重量部、好ましくは0.5 ~7重量部である。前記合計使用量が0.1重量部未満 では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方1 0 重量部を超えると、放射線の透過率が低下して、矩形 のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。ま た、酸発生剤(B)に対する酸発生剤(b)の使用割合 は、通常、70重量%以下である。

【0020】さらに、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、必要に応じて、各種の添加剤を配合することができ る。例えば、レジストとしての感度、耐ドライエッチン グ性およびパターン形状を改善するために、低分子の機 能性化合物を配合することができる。このような機能性 化合物としては、例えば、1-アダマンタノール、3-アダマンタノール、1-アダマンタンメタノール、3-アダマンタンメタノール、1,3-ジアダマンタノー ル、1、3-アダマンタンジメタノール、1-アダマン タンカルボン酸、3-アダマンタンカルボン酸、1,3 -アダマンタンジカルボン酸、1-アダマンタン酢酸、 3-アダマンタン酢酸、1,3-アダマンタンジ酢酸、 3-メチル-2-ノルボルナンメタノール、ミルタノー ル、しょうのう酸、シスービシクロ[3.3.0]オク タン-2-カルボン酸、2-ヒドロキシ-3-ピナノ ン、カンファン酸、3-ヒドロキシ-4,7,7-トリ メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-酢酸、 1, 5-デカリンジオール、4, 8-ビス (ヒドロキ シ) トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカン、ボルネ オール、1-ノルアダマンタンカルボン酸、3-ノルア ダマンタンカルボン酸、2-ノルボルナン酢酸、1,3 ーノルボルナンジオール、2,3-ノルボルナンジオー ル、2,5-ノルボルナンジオール、2,6-ノルボル ナンジオール、4ーペンチルビシクロ[2.2.2]オ クタン-1-カルボン酸、ピナンジオール、1-ナフタ

レンメタノール、2-ナフタレンメタノール、1-ナフ トール、2ーナフトール、1ーナフタレンカルボン酸、 2-ナフタレンカルボン酸、(1-ナフトキシ)酢酸、 (2-ナフトキシ) 酢酸、1-ナフチル酢酸、2-ナフ チル酢酸、1,2-ナフタレンジメタノール、1,3-ナフタレンジメタノール、1,4-ナフタレンジメタノ ール、1,5-ナフタレンジメタノール、1,6-ナフ タレンジメタノール、1,7-ナフタレンジメタノー ル、1,8-ナフタレンジメタノール、2,3-ナフタ レンジメタノール、2,6-ナフタレンジメタノール、 2, 7ーナフタレンジメタノール、1, 2ージヒドロキ シナフタレン、1,3-ジヒドロキシナフタレン、1, 4-ジヒドロキシナフタレン、1,5-ジヒドロキシナ フタレン、1,6-ジヒドロキシナフタレン、1,7-ジヒドロキシナフタレン、1,8-ジヒドロキシナフタ レン、2,3-ジヒドロキシナフタレン、2,6-ジヒ ドロキシナフタレン、2, 7-ジヒドロキシナフタレ ン、(1,2-ナフトキシ)ジ酢酸、(1,3-ナフト キシ) ジ酢酸、(1, 4-ナフトキシ) ジ酢酸、(1,5-ナフトキシ) ジ酢酸、(1,6-ナフトキシ) ジ酢 酸、(1, 7-ナフトキシ)ジ酢酸、(1, 8-ナフト キシ) ジ酢酸、(2,3-ナフトキシ) ジ酢酸、(2, 6-ナフトキシ) ジ酢酸、(2, 7-ナフトキシ) ジ酢 酸、1,2-ナフタレンジカルボン酸、1,3-ナフタ レンジカルボン酸、1,4-ナフタレンジカルボン酸、 1,5-ナフタレンジカルボン酸、1,6-ナフタレン ジカルボン酸、1,7-ナフタレンジカルボン酸、1, 8-ナフタレンジカルボン酸、2,3-ナフタレンジカ ルボン酸、2,6ーナフタレンジカルボン酸、2,7-ナフタレンジカルボン酸、1,2-ナフチルジ酢酸、 1,3-ナフチルジ酢酸、1,4-ナフチルジ酢酸、 1,5-ナフチルジ酢酸、1,6-ナフチルジ酢酸、 1, 7-ナフチルジ酢酸、1, 8-ナフチルジ酢酸、 2,3ーナフチルジ酢酸、2,6ーナフチルジ酢酸、 2. 7ーナフチルジ酢酸、3-ヒドロキシ-1. 8-ジ カルボキシナフタレン、1-ヒドロキシ-2-カルボキ シナフタレン、3-ヒドロキシ-2-カルボキシナフタ レン、4-ヒドロキシー2-カルボキシナフタレン、5 ーヒドロキシー2ーカルボキシナフタレン、6ーヒドロ キシー2-カルボキシナフタレン、7-ヒドロキシー2 ーカルボキシナフタレン、8-ヒドロキシ-2-カルボ キシナフタレン、2-ヒドロキシ-1-カルボキシナフ タレン、3-ヒドロキシ-1-カルボキシナフタレン、 4-ヒドロキシ-1-カルボキシナフタレン、5-ヒド ロキシー1-カルボキシナフタレン、6-ヒドロキシー 1-カルボキシナフタレン、7-ヒドロキシ-1-カル ボキシナフタレン、8-ヒドロキシ-1-カルボキシナ フタレン、1-カルボキシー2-ナフトキシ酢酸、3-カルボキシー2ーナフトキシ酢酸、4ーカルボキシー2

ーナフトキシ酢酸、5-カルボキシー2-ナフトキシ酢

酸、6-カルボキシー2-ナフトキシ酢酸、7-カルボ キシー2-ナフトキシ酢酸、8-カルボキシー2-ナフ トキシ酢酸、2-カルボキシ-1-ナフトキシ酢酸、3 - カルボキシー1-ナフトキシ酢酸、4-カルボキシー 1-ナフトキシ酢酸、5-カルボキシ-1-ナフトキシ 酢酸、6-カルボキシー1-ナフトキシ酢酸、7-カル ボキシー1ーナフトキシ酢酸、8-カルボキシー1ーナ フトキシ酢酸等や、これらの化合物中のカルボキシル基 あるいは水酸基中の水素原子を酸解離性官能基で置換し た化合物等を挙げることができる。ここで、酸解離性官 能基としては、例えば、樹脂(A)について例示した酸 解離性官能基と同様の基を挙げることができる。これら の機能性化合物は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。機能性化合物の使用量は、樹脂 (A) 100重量部に対して、通常、50重量部以下で ある。

【0021】また、塗布性、現像性を改良する作用を示 す界面活性剤を配合することができる。このような界面 活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリル エーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポ リオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレ ンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニ ルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレ ート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニ オン系界面活性剤のほか、以下商品名で、KP341 (以上、信越化学工業製)、ポリフローNo. 75、同 No. 95 (以上、共栄社油脂化学工業製)、エフトッ プEF301、同EF303, 同EF352 (以上、新 秋田化成製)、メガファックスF171、同F173 (以上、大日本インキ化学工業製)、フロラードFC4 30、同FC431 (以上、住友スリーエム製)、アサ ヒガードAG710、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-1 04、同SC-105、同SC-106(以上、旭硝子 製) 等を挙げることができる。界面活性剤の使用量は、 樹脂(A)100重量部に対して、通常、2重量部以下 である。

【0022】また、感放射線性酸発生剤から発生する酸に対してルイス塩基として作用する化合物(以下、「ルイス塩基化合物」という。)を添加することにより、レジストパターンの側壁の垂直性をより効果的に改善することができる。このようなルイス塩基化合物としては、例えば、含窒素塩基性化合物、含窒素塩基性化合物の塩類、カルボン酸類、アルコール類等を挙げることができる。好ましいルイス塩基化合物は、トリエチルアミン、トリイソプロピルアミン、トリローブチルアミン、トリコープチルアミン、トリコースキシルアミン、トリエタノールアミン、トリコニースチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、1ーナフチルアミン、2

ーナフチルアミン、ジフェニルアミン、エチレンジアミ ン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミ ン、ピロリジン、ピペリジン等のアミン化合物;イミダ ゾール、4ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフ ェニルイミダゾール、チアベンダゾール等のイミダゾー ル化合物;ピリジン、2-メチルピリジン、4-エチル ピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジ ン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、アクリ ジン等のピリジン化合物;プリン、1,3,5-トリア ジン、トリフェニルー1,3,5ートリアジン、1, 2, 3-トリアゾール、1, 2, 4-トリアゾール、ウ ラゾール等の他の含窒素複素環化合物等を挙げることが できる。これらの含窒素塩基性化合物は、単独でまたは 2種以上を混合して使用することができる。ルイス塩基 化合物の使用量は、酸発生剤(B)および酸発生剤 (b) の合計100重量部に対して、通常、5重量部以

(b) の合計100重量部に対して、通常、5重量部以下である。ルイス塩基化合物の使用量が5重量部を超えると、レジストとしての感度が低下する傾向がある。さらに、その他の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等を挙げることができる。

【0023】本発明の感放射線性樹脂組成物は、樹脂 (A) および酸発生剤(B) を必須の構成成分とし、必 要に応じて酸発生剤(b)や各種の添加剤等を含有する が、その使用に際しては、全固形分の濃度が、例えば5 ~50重量%となるように、溶剤に溶解したのち、通 常、例えば孔径 0. 2 μ m程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、エチ レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテル、エチレングリコールモノーnー プロピルエーテル、エチレングリコールモノー n ーブチ ルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、 ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレング リコールジーn-プロピルエーテル、ジエチレングリコ ールジ-n-ブチルエーテル、エチレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノー n-プロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレ ン、メチルエチルケトン、メチルn-プロピルケトン、 メチルイソプロピルケトン、メチル n ーブチルケトン、 メチルイソブチルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタ ノン、4-ヘプタノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロ キシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテ

ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸 エチル、酢酸n-プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸n ープチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン 酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、 N、N-ジメチルアセトアミド等を挙げることができ る。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用される。さらに前記溶剤には、必要に応じて、ベン ジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、ジエチレン グリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコール モノエチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロ ン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息 香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 y -ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、 フェニルセロソルブアセテート等の高沸点溶剤を1種以 上併用することができる。

【0024】本発明の感放射線性樹脂組成物を用いてレ ジストパターンを形成する際には、前記のようにして調 製された組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗 布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコンウエ ハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に 塗布することにより、レジスト被膜を形成し、場合によ り予めプレベークを行ったのち、所定のレジストパター ンを形成するように該レジスト被膜に露光する。露光に 使用される放射線としては、波長が220nm以下の放 射線、特にArFエキシマレーザー(波長193nm) が好ましい。但し、所望により波長が220nm以下の 他の放射線を使用することもできる。本発明において、 レジスト被膜のArFエキシマレーザーに対する透過率 は、感放射線性樹脂組成物の所望の特性に応じて変わる が、レジスト被膜1μm当たり、好ましくは35~90 %、特に好ましくは40~85%である。前記透過率が 35%未満では、解像度、パターン形状等が低下する傾 向があり、一方90%を超えると、感度が低下する傾向 がある。本発明においては、露光後に加熱処理(以下、 「露光後ベーク」という。) を行うことが好ましい。こ の露光後ベークにより、樹脂(A)中に含有される酸解 離性基の解離、即ちナフトール性水酸基、カルボキシル 基等の酸性官能基の生成反応が、レジスト被膜内で円滑 に進行する。その加熱温度は、樹脂組成物の配合組成に よって変わるが、通常、30~200℃、好ましくは5 0~170℃である。本発明においては、感放射線性樹 脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特 公平6-12452号公報等に開示されているように、 使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜 を形成しておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれ る塩基性不純物の影響を防止するため、例えば特開平5

-188598号公報等に開示されているように、レジ スト被膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれ らの技術を併用することもできる。次いで、露光された レジスト被膜を現像することにより、所定のレジストパ ターンを形成させる。本発明の感放射線性樹脂組成物に 対する現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水 酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、メ タけい酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、n ープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピル アミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジ メチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリ ジン、コリン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0] -7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロー[4. 3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少なくと も1種を溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。このア ルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下であ る。アルカリ性水溶液の濃度が10重量%を超えると、 未露光部も現像液に溶解するおそれがあり、好ましくな い。また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液には、 例えば有機溶剤を添加することもできる。前記有機溶剤 としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ ブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、 3-メチル-2-シクロペンタノン、2,6-ジメチル シクロヘキサノン等のケトン類;メチルアルコール、エ チルアルコール、nープロピルアルコール、イソプロビ ルアルコール、nーブチルアルコール、イソブチルアル コール、t-ブチルアルコール、シクロペンタノール、 シクロヘキサノール、1,4-ヘキサンジオール、1, 4-ヘキサンジメチロール等のアルコール類; テトラヒ ドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;酢酸エチル、 酢酸nープロピル、酢酸イソプロピル、酢酸nーブチ ル、酢酸イソブチル、酢酸n-アミル、酢酸イソアミル 等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水 素類や、フェノール、アセトニルアセトン、N, N-ジ メチルホルムアミド等を挙げることができる。これらの 有機溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。有機溶剤の使用量は、アルカリ性水溶液 に対して、100容量%以下が好ましい。有機溶剤の使 用量が100容量%を超えると、現像性が低下し、露光 部の現像残りが多くなるおそれがある。また、アルカリ 性水溶液からなる現像液には、界面活性剤等を適量添加 することもできる。なお、アルカリ性水溶液からなる現 像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄して乾燥す る。

[0025]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。実 施例および比較例における各測定および評価は、下記の 要領で行った。

Mwおよび分散度

東ソー (株) 製GPCカラム (G2000Hx 2本、G3000Hx 1本、G4000Hx 1本) を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) により測定した。

放射線透過率

各組成物溶液を石英ガラス上にスピナーを用いて塗布し、90℃に保持したホットプレート上で1分間ベークして得た膜厚1μmのレジスト被膜について、波長193nmにおける吸光度から透過率を算出して、違紫外線領域における透明性の尺度とした。

威度

各組成物溶液を、シリコーンウエハー上にスピナーを用いて塗布したのち、100 に保持したホットプレート上で、2 分間プレベークを行って、膜厚1. 1_{μ} mのレジスト被膜を形成した。このレジスト被膜に、マスクパターンを介し、(株) ニコン製ArFエキシマレーザー 露光機(レンズ開口数:0.55)を用い、露光量を変化させて、A rFエキシマレーザー(波長193 n m)により露光した。次いで、110 でに保持したホットプレート上で、1 分間露光後ベークを行ったのち、2.3 8 重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25 で 1 分間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。このとき、線幅0.30 μ mのライン・アンド・スペースパターン(1 L1S)を1 対1 の幅に生成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

解像度

最適露光量で露光したときに解像されている最小のレジストパターンの寸法を、解像度とした。

現像性

スカムや現像残りの程度を、走査型電子顕微鏡で観察した。

パターン形状

線幅 0.30μ mのライン・アンド・スペースパターン (1 L 1 S) の方形状断面の下辺寸法 L a と上辺寸法 L b とを走査型電子顕微鏡により測定し、 $0.85 \le L$ b / L a ≤ 1 である場合を、パターン形状が"良好"であるとした。但し、0.85 > L b / L a の場合、および $0.85 \le L$ b / L a ≤ 1 であっても、パターン形状が裾を引いていたり、逆テーパー状となっている場合は、パターン形状が"不良"とした。

【0026】 〔樹脂 (A) の合成〕

合成例1

メタクリル酸 t ーブチル/メタクリル酸トリシクロデカニル/メタクリル酸共重合体の合成

容量300ミリリットルの三方活栓付きフラスコに入れ

た乾燥テトラヒドロフラン80ミリリットルに、アルゴ ンガス雰囲気中で、メタクリル酸 t ーブチル11.58 g(0.068モル)、メタクリル酸トリシクロデカニ ル15.0g(0.068モル)およびメタクリル酸 2. 93g(0.034モル)を溶解した。この溶液 に、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル0. 918g(0.0056モル)のテトラヒドロフラン溶 液30ミリリットルを加え、60~70℃に1時間加熱 して重合を行った。重合後、反応溶液をヘキサン1リッ トル中に注いで、ポリマーを再凝集沈殿させる操作を2 回繰り返したのち、ポリマーをろ過して回収し、2mm Hg、40℃で24時間乾燥して、白色ポリマー15. Ogを得た。このポリマーは、「H-NMR測定により 求めたメタクリル酸 t ーブチル/メタクリル酸トリシク ロデカニル/メタクリル酸のモル比が40/40/2 0、Mwが49,600、分散度が2.17の共重合体 であった。この共重合体を、樹脂(A1)とする。

【0027】合成例2

メタクリル酸テトラヒドロピラニル/メタクリル酸トリシクロデカニル/メタクリル酸共重合体の合成単量体として、メタクリル酸テトラヒドロピラニル8.69g(0.051モル)、メタクリル酸トリシクロデカニル18.8g(0.085モル)およびメタクリル酸1.47g(0.017モル)を用いた以外は、合成例1と同様にして、ポリマー16.5gを得た。なお、メタクリル酸テトラヒドロピラニルは、「G.N.Taylorら: Chemistry Material,3(6),1031-1040(1991)」に記載された方法より合成した。このポリマーは、「HーNMR測定により求めたメタクリル酸テトラヒドロピラニル/メタクリル酸トリシクロデカニル/メタクリル酸のモル比が35/55/10、Mwが50,000、分散度が2.00の共重合体であった。この共重合体を、樹脂(A2)とする。

【0028】合成例3

メタクリル酸 t ープトキシカルボニル/メタクリル酸ト リシクロデカニル/メタクリル酸共重合体の合成

(i) アルカリ可溶性樹脂(a) の合成

単量体として、メタクリル酸トリシクロデカニル22.5g(0.102モル) およびメタクリル酸5.88g(0.068モル) を用いた以外は、合成例1と同様にして、メタクリル酸トリシクロデカニル/メタクリル酸のモル比が60/40、Mwが15,000、分散度が1.90の共重合体20.5gを得た。

(ii) 酸解離性官能基の導入

容量300ミリリットルの三方活栓付きフラスコに入れた乾燥ジオキサン80ミリリットルに、アルゴンガス雰囲気中で、(i)で得たアルカリ可溶性樹脂(a)28.4g、ジーtーブチルジカーボネート10.30g(0.051モル)およびトリエチルアミン5.15g(0.051モル)を溶解したのち、60~70℃で7

時間反応させた。次いで、反応溶液をヘキサン1リットル中に注いで、ポリマーを再凝集沈殿させる操作を2回繰り返したのち、ポリマーをろ過して回収し、2mmHg、40℃で24時間乾燥して、白色ポリマー18.0gを得た。このポリマーは、「H-NMR測定により求めたメタクリル酸tープトキシカルボニル/メタクリル酸トリシクロデカニル/メタクリル酸のモル比が30/60/10、Mwが18,000、分散度が1.90の共重合体であった。この共重合体を、樹脂(A3)とする。

【0029】合成例4

4- (1-エトキシエトキシ) -1-ナフタレン/4-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレン共重合体の合成

(i) アルカリ可溶性樹脂(a) の合成

単量体として、4ーヒドロキシー1ービニルナフタレン11.56(0.068モル)を用いた以外は、合成例1と同様にして、Mwが20,000、分散度が2.17のポリ(4ーヒドロキシー1ービニルナフタレン)10.0gを得た。

(ii) 酸解離性官能基の導入

容量300ミリリットルの三方活栓付きフラスコに入れ た乾燥ジオキサン80ミリリットルに、アルゴンガス雰 囲気中で、(i)で得たアルカリ可溶性樹脂(a)1 1. 3g、エチルビニルエーテル1. 47g (0. 02 0 モル) および p ートルエンスルホン酸ピリジニウム 0.265g(0.001モル)を溶解したのち、攪拌 下、室温で24時間反応させた。次いで、反応溶液をト リエチルアミンを用いて中和したのち、ヘキサン1リッ トル中に注いで、ポリマーを再凝集沈殿させる操作を2 回繰り返したのち、ポリマーをろ過して回収し、2mm Hg、40℃で24時間乾燥して、白色ポリマー10. Ogを得た。このポリマーは、1H-NMR測定により 求めた4-(1-エトキシエトキシ) -1-ビニルナフ タレン/4-ヒドロキシ-1-ビニルナフタレンのモル. 比が30/70、Mwが21,000、分散度が2.1 0の共重合体であった。この共重合体を、樹脂(A4) とする。

【0030】〔酸発生剤(B)の合成〕 合成例5

1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタン スルホネートの合成

ヨウ化エチル4.7g(0.03モル)、

【0031】 【化3】



【0032】3.74g(0.03モル)および乾燥テトラヒドロフラン100ミリリットルを混合したのち、 攪拌下、室温で30分間反応させた。次いで、反応溶液 に水200ミリリットルを添加したのち、ジエチルエーテル200ミリリットルで抽出し、エーテル層を15重量%炭酸ナトリウム水溶液で洗浄した。その後、エーテルを留去し、粗生成物を蒸留により精製して、1-ナフチルエチルスルファイド3.4g(0.021モル)を得た。次いで、1-ナフチルエチルスルファイド3.4g(0.021モル)、エチルトリフルオロメタンスルホネート(C2lls-0-SO2-CF3)3.74g(0.021モル)および乾燥ジクロロメタン25ミリリットルを混合したのち、攪拌下、室温で15時間反応させた。その後、ジクロロメタンを留去したのち、反応生成物をイソプロピルアルコールを用いて再結晶させて、1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート3.5g(0.0105モル)を得た。

【0033】合成例6

4 ーシアノー 1 ーナフチルジエチルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネートの合成

ヨウ化メチル4.26g(0.03モル)、

[0034] [化4] SNa CN

【0035】6. 21g (0. 03モル) および乾燥テ トラヒドロフラン100ミザリットルを混合したのち、 攪拌下、室温で30分間反応させた。次いで、反応溶液 に水200ミリリットルを添加したのち、ジエチルエー テル200ミリリットルで抽出し、エーテル層を15重 量%炭酸ナトリウム水溶液で洗浄した。その後、エーテ ルを留去し、粗生成物を蒸留により精製して、4-シア ノー1-ナフチルエチルスルファイド4.48g(0. 0225モル)を得た。次いで、4-シアノ-1-ナフ チルエチルスルファイド4. 48g(0. 0225モ ル)、エチルトリフルオロメタンスルホネート3.69 g(0.0225モル)および乾燥ジクロロメタン25 ミリリットルを混合したのち、攪拌下、室温で15時間 反応させた。その後、ジクロロメタンを留去したのち、 反応生成物をイソプロピルアルコールを用いて再結晶さ せて、4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート4.09g(0.01 125モル)を得た。

[0036]

【実施例】

実施例1~6および比較例1~2

合成例1~4で得た各樹脂を用い、表1に示す感放射線性酸発生剤および溶剤を混合して、均一溶液としたのち、孔径0.2μmのメンブランフィルターでろ過して、表1(部は、重量に基づく。)に示す組成物溶液を調製した。得られた各組成物溶液について、各評価を行

った。評価結果を、表 2 に示す。表 1 の各成分は、下記 のとおりである。

【0037】感放射線性酸発生剤

B1: 4ーヒドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

【化5】

【0038】B2: 1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

【化6】

【0039】B3: 4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

【化7】

【0040】b1: シクロヘキシルメチル (2ーオキ ソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート

【化8】

【0041】b2: トリフェニルスルホニウムトリフ

ルオロメタンスルホネート

【化9】

【0042】溶剤

α : 2-ヘプタノン

 β : 2-ヒドロキシプロピオン酸エチル

[0043]

【表 1 】

•		表1	
	樹脂 (A)	感放射線性酸発生剤	溶剤
	(部)	(部)	(部)
実施例1	A 1	B 1 / b 1	a/β
	(100)	(1.0) / (0.7)	(375)/(161)
実施例2	A 2	B 1/b 2	α
	(100)	(2.0)/(0.5)	(523)
実施例3	A 3 .(100)	B 1 (2.0)	$\frac{\alpha}{\beta}$ (467) / (200)
実施例 4	A 4	B 3 / b 1	α
	(100)	(2.0) / (1.0)	(5 4 5)
実施例5	A 1 / A 3	B 1 / b 2	α/β
	(50) / (50)	(1.5) / (1.5)	(375)/(161)
実施例6	A 3	B 2	α
	(100)	(2.5)	(5 4 5)
比較例1	A 1	b 1	α/β
	(100)	(2.7)	(375)/(161)
比較例2	A 2	b 2	α
	(100)	(1.5)	(523)

[0044]

【表2】

例	放射線透過率 (%)	感度 (mJ/cm²)	解像度 (μm)	現像性	パターン形状
実施例1	6 0	3 5	0. 18	良好	良好
実施例 2	5 0	2 5	0, 18	良好	良好
実施例3	5 5	2 5	0, 20	良 好	良好
実施例4	5 0	2 1	0. 22	良好	良好
実施例5	5 0	2 5	0. 22	良好	良好
実施例6	6 5	3 0	0, 20	良好	良好
比較例i	7 0	8 0	0. 36	不良	不良
比較例2	4 0	40	0. 30	不良	不良

[0045]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に ArFエキシマレーザー(波長193nm)に対する透 明性が高く、しかも感度、解像度、現像性、パターン形 状等にも優れている。したがって、本発明の感放射線性 樹脂組成物は、波長220nm以下の短波長の放射線を 用いる化学増幅型レジストとして、今後ますます高集積 化が進行するとみられる集積回路素子の製造に極めて好 適に使用することができる。